

⑯日本国特許庁

公開特許公報

⑮特許出願公開

昭53-45679

⑯Int. Cl.² 識別記号
B 01 J 17/18 //
C 01 B 33/02

⑰日本分類 厅内整理番号
13(7) D 522.2 7158-4A
99(5) A 02 6370-57
10 R 33 7047-42

⑯公開 昭和53年(1978)4月24日
発明の数 1
審査請求 有

(全3頁)

⑯シリコン単結晶引上装置

⑯特 願 昭51-120355

⑯出 願 昭51(1976)10月8日

⑯發明者 江頭悦郎

小平市上水本町1450番地 株式

会社日立製作所武藏工場内

同 藤田正人

小平市上水本町1450番地 株式

会社日立製作所武藏工場内

⑯發明者 三好信一郎

小平市上水本町1450番地 株式

会社日立製作所武藏工場内

⑯出願人 株式会社日立製作所

東京都千代田区丸の内一丁目5

番1号

⑯代理人 弁理士 薄田利幸

明細書

発明の名称 シリコン単結晶引上装置

特許請求の範囲

るつぼ、ヒーター、シールド及びシードチャックその他の黒鉛製加熱治具をシリコンカーバイトでそれぞれ被つてなることを特徴とするシリコン単結晶引上装置。

発明の詳細な説明

本発明はシリコン単結晶引上装置に関するものである。

従来においてはOZ-S1単結晶引上装置の加熱治具は原子炉用高純度カーボン材によりつくられていた。ここでいう加熱治具とは加熱用ヒーター、るつぼ、ヒートシールドおよびその他引上炉内の治具類のうちで石英や銅等以外のカーボンでつくられた一切の治具のことである。

ところで、OZ-S1単結晶中にはドープ用不純物元素の他に酸素や炭素が無視できない程度に含まれていることが知られている。そして、炭素については炉内の黒鉛治具から加熱によってガス

化したあるいはOZが溶融したシリコン中に侵入することが主原因であることが明らかにされている。

したがつて、特に低炭素濃度のS1結晶を得るにはOZ(フローティングゾーン)結晶法によらなければならなかつた。

すなわちOZ-S1単結晶引上法によれば $1 \times 10^{14} \sim 5 \times 10^{17}$ atoms/cc程度(通常の場合 $5 \times 10^{14} \sim 1 \times 10^{17}$ atoms/cc)の炭素が含まれているので、それ以下の炭素濃度の単結晶S1はOZ法では得られなかつた。

しかるに、S1単結晶中の炭素濃度が 1.5×10^{17} atoms/ccを超えるとパワー用デバイスで特に問題とされるリーク電流の増大、耐圧の低下が生じる。

したがつて、本発明はS1中の炭素濃度をより低くすることを目的とするものである。

上記目的を達成するための本発明の基本的構成は、るつぼ、ヒーター、シールド及びシードチャックその他の黒鉛製加熱治具をシリコンカーバイ

トでそれぞれ被つてなることを特徴とするものである。

以下本発明を実施例により説明する。第1図は本発明の一実施例を示すものである。

同図において1は溶融シリコンおよび石英ルツボを収納するるつぼ、2は日1を溶融するための熱を発生せしめる加熱ヒーター、3は上部を被りトップシールド、4は装置の周辺部を被りアウターシールド、5はインナーシールド、6は底部において外部と遮蔽するボトムシールド、8は上記加熱ヒーターに電力を伝える電極(プラグ)、9はロアーシールド(ヒートリフレクタ)、10はペデスタル、11はシードを据むシードチャックである。以上の部品すべてはシリコンカーバイト(sic)でコーティングされている。

なお、日1は不良導体なので電極部分については電力伝達のため局部的にコーティング層を剥しておく必要がある。

この本発明に係るシリコン単結晶引上装置によれば、装置内におけるカーボン材はカーボンウー

(3)

トができる。

図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例を示す引上装置の断面図である。第2図は炭素濃度を示す曲線図である。

1...るつぼ、2...ヒーター、3...トップシールド、4...アウターシールド、5...インナーシールド、6...ボトムシールド、8...電極、9...ロアーシールド、10...ペデスタル、11...シードチャック、12...カーボンウール、13...シード、14...日1単結晶、15...溶融シリコン、16...石英ルツボ。

代理人弁理士薄田利幸

ルを除きすべて日1により完全に被われており、また、カーボンウールについてはこれら日1でコーティングされた治具で囲われ、開口部がない。

したがつて、加熱中にカーボン材に含まれる水分や炉内雰囲気中の微量のO₂と結合して発生したCOガスあるいは劣化したカーボンそのものが微粉体として溶融シリコン中へ侵入することが防止され、当然に日1単結晶中の炭素濃度が低くなるのである。

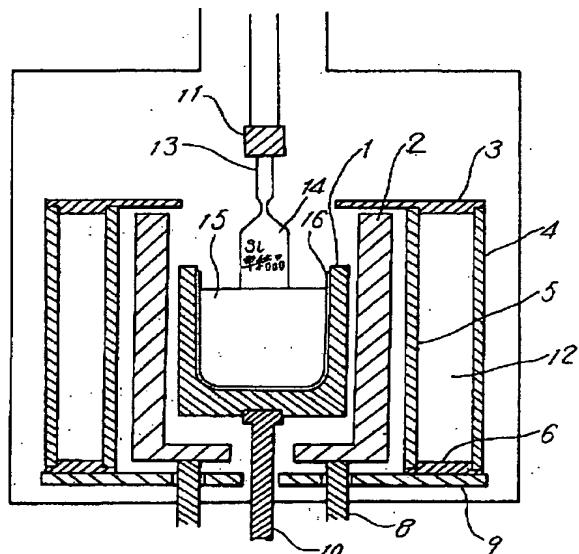
第2図は日1単結晶中のカーボン量について従来の黒鉛治具を使用した場合と本発明のSiCコート治具を使用した場合について測定した結果を示すもので、横軸の座標にfunction solidified (x)すなわち引上単結晶重量/チャージ結晶重量をとり、縦軸の座標にcarbon contents (単位atomic ppm)をとる。

この結果も明らかのように、本発明の方が炭素濃度が低いのである。

本発明はCZ単結晶引上装置全般に適用するこ

(4)

第1図



(5)

